



ООО Мегасм, Москва, Зеленоград. +7-916-681-16-85

Параметры подложек антимонида индия и антимонида галлия InSb GaSb Wafers Specifications

Материала подложки Substrates material	InSb		GaSb	
Легирующая примесь Dopant	нелегированный undopend	Te	нелегированный undopend	Te
Тип проводимости Conductivity type	n-тип / n-type	n-тип / n-type	p-тип / p-type	n-тип / n-type
Метод выращивания кристалла Crystal growth method	Модифицированной метод Чохральского Modified Czochralski method (LEC)			
Ориентация поверхности Surface orientation	(100) / (111)			
Разориентация поверхности Misorientations, orientation tolerance	0° ±0.5°			
Диаметр, мм (дюйм) Wafer diameter, mm	50.8 (2") / 76.2 (3") / 100		50.8 (2") / 76.2 (3")	
Допуск на диаметр, мм Diameter tolerance, mm	±0.2			
Диапазон номинальной толщины подложки, мкм Thickness, μm	625 ±25 ø 50.8 (2") 800 / 900 ±25 ø 76.2 (3") 1000 ±25 ø 100 мм		500 ±25 ø 50.8 (2") 625 ±25 ø 76.2 (3")	
Плотность дислокаций, см ⁻² Etch Pitch Density (EPD), cm ⁻²	≤ 100		≤ 2000 ø 50.8 (2") ≤ 5000 ø 76.2 (3")	
Концентрация носителей заряда, см ⁻³ Carrier concentration (CC), cm ⁻³	3×10 ¹⁴ ÷ 3×10 ¹⁵	5×10 ¹⁵ ÷ 1×10 ¹⁸	≤ 2×10 ¹⁷	2×10 ¹⁷ ÷ 1×10 ¹⁸
Подвижность носителей заряда, см ² /(В·с) Hall mobility, cm ² /Vs	> 4×10 ⁵	> 1×10 ⁴	> 600	3500 ÷ 2000
Основной базовый срез Orientation Flat (OF)	EJ SEMI (01̄1̄) ±1° US SEMI (01̄1̄) ±1°			
Длина основного базового среза, мм Orientation Flat Length (OF), mm	16 ±2 ø 50.8 (2") 22 ±2 ø 76.2 (3") 32.5 ±2 ø 100			
Дополнительный базовый срез Identification Flat (IF)	EJ SEMI (01̄1̄) – поворот на 90° по часовой стрелке от основного базового среза / clockwise (CW) US SEMI (011) – поворот на 90° против часовой стрелке от основного среза / counter clockwise (CCW)			
Длина дополнительного базового среза, мм Identification Flat Length (IF), mm	8 ±1.0 ø 50.8 (2") 11 ±1.0 ø 76.2 (3") 18 ±1.0 ø 100			
Лицевая / обратная поверхности подложек Surface Specifications (face / reverse)	полированная «epi-ready» / полированная или шлифованно-травленная polish «epi-ready» / polish or etched (PP or PE)			
Тара и упаковка Packaging	индивидуальный или групповой контейнер, вакуумированный пакет single wafer container or cassette			